改性 TiO₂ 纳米管阵列电极的光电化学性能研究

靳雨馨¹,石颖哲¹,王 璇^{1,2}

(1. 内蒙古大学 生态与环境学院, 内蒙古 呼和浩特 010021)

(2. 内蒙古自治区环境污染控制与废物资源化重点实验室, 内蒙古 呼和浩特 010021)

摘 要:近年来,掺杂改性的 TiO₂纳米管作为光催化材料的研究受到广泛关注。本实验采用阳极氧化法在 Ti 板表面制 备规则有序的 TiO₂纳米管,通过在电解液中直接添加含 Fe、N 元素的化学试剂对其进行掺杂改性。利用扫描电子显微 镜、X 射线衍射仪和 X 射线光电子能谱对 TiO₂纳米管进行表征,确定 TiO₂纳米管的最佳制备条件。最后利用瞬态光电 流曲线、开路电位曲线、线性伏安扫描曲线对其光电化学性能进行比较。研究发现,1%的 Fe 元素掺杂材料具有更好的 光电响应,光照时开路电位可达 0.345 V;9%的 N 元素掺杂材料具有最好的光电活性,光照时开路电位可达 0.3 V。 关键词: 阳极氧化法;TiO₂纳米管;改性;光电化学性能

中图法分类号: O643.36 文献标识码: A 文章编号: 1002-185X(2021)02-0614-07

TiO₂是一种 N 型半导体,它是光催化材料的重要 代表之一。具有规则多孔特性的 TiO₂ 纳米管阵列是 TiO₂ 的一类特殊结构,由于其对电子传输和电解质传 导速率的促进作用,有利于 TiO₂ 光电化学性能的提 高,因此受到广泛关注。TiO₂ 纳米管材料常见的制备 方法有水热合成法、电沉积法、模板法等,但这些方 法制备过程复杂、成本高,不利于实现工业化和能源 化^[1]。目前,有学者采用含 F⁻体系的阳极氧化法在 Ti 基体上成功制备了 TiO₂ 纳米管^[2],这种方法因设备成 本低、操作简单、反应过程易控制且不会产生二次污 染而得到广泛应用。

传统的 TiO₂带隙能 (3.2 eV) 较宽,只能被波长 λ<380 nm 的紫外光激发,而太阳光谱中紫外光仅有 5%左右,因此,如何拓展 TiO₂ 的光响应范围是光催 化技术的热点和难点。通过研究发现,采用金属掺杂、 非金属掺杂、半导体复合、染料敏化等方法^[3]对 TiO₂ 晶体结构进行改变,可减小带隙能,有利于获得对可 见光响应的 TiO₂纳米管。Fe³⁺具有半充满 d 电子构型, 且离子半径与 Ti⁴⁺相近,是理想的掺杂元素之一^[4]。 在对 TiO₂进行改性的非金属元素中,N 原子由于具有 和 O 原子相近的尺寸以及较小的电离能而被认为是最 有效的掺杂剂^[4]。

本研究在不同条件下,采用阳极氧化法在 Ti 板表 面制备规则有序的 TiO₂纳米管,对其形貌、结构、晶 体及性能进行比较,确定 TiO₂纳米管的最佳制备条 件。在最佳条件下,分别对钛基 TiO₂纳米管材料进行 Fe、N 掺杂,通过 X 射线衍射仪和 X 射线光电子能谱 对 TiO₂纳米管的晶体结构和元素进行表征,研究掺杂 浓度对材料结构和性能的影响。并分别在光照和非光 照条件下利用电化学工作站扫描电极体系的瞬态光电 流曲线、开路电位-时间曲线、线性伏安扫描曲线,分 析此阵列电极的光电化学性能。

1 实 验

实验试剂:氢氟酸、浓硝酸、乙醇、丙酮、尿素、 六水合三氯化铁、硫酸钠均为分析纯。

实验仪器:磁力搅拌器(C-MAG HS7S25)、扫描 电子显微镜(SU8010)、X射线衍射仪(Empyrean 锐 影)、X射线光电子能谱(ESCALABXI)、电化学工作 站(Zennium-Pro)、恒定电源(KXN-305D)、马弗炉 (SX-G01123)。

预处理:将工业纯钛片(纯度为 99.95%, 0.2 mm 厚)裁剪成 2 cm×2 cm 的正方形,依次使用 400#、800# 和 1200#砂纸向同一方向打磨至光滑。将打磨完成的 钛片放入混合酸溶液(HF:HNO₃:H₂O=1:4:5)中浸泡 5 min 进行酸洗,取出后分别用乙醇、丙酮和去离子水 超声清洗基体钛片。

阳极氧化法处理:室温下,以预处理后的 Ti 片为 阳极,Ni 片为阴极置于电化学单室电解池中,电解液 为一定浓度的 NH₄F 水溶液,电极间距为 3 cm,施加

收稿日期: 2020-02-25

基金项目:内蒙古自治区自然科学基金(2019BS02013);内蒙古自治区高等学校科研项目(NJZY18011)

作者简介: 靳雨馨, 女, 1995 年生, 硕士, 内蒙古大学生态与环境学院, 内蒙古 呼和浩特 010021, E-mail: 278915810@qq.com

恒定电压,对钛片进行阳极氧化处理。实验过程中辅 以转速为 200 r/min 的磁力搅拌,保持电解液均匀。一 定时间后停止氧化,将阳极用超纯水冲洗干净,在空 气中自然晾干后放入马弗炉中以 10 ℃/min 的升温速 率至一定温度进行退火处理 240 min,冷却后即可得 到 Ti 基 TiO₂纳米管阵列电极。

用控制变量法制备 TiO₂ 纳米管阵列的实验条件 如表1所示,研究不同条件对 TiO₂纳米管阵列的影响, 从而得到最佳制备条件。

在 TiO₂纳米管阵列的最佳制备条件下,对其进行 掺杂。使用去离子水配制分别含有质量分数为 0.1%、 0.5%、0.9%的 Fe 和 N 元素的 NH₄F 电解液,通过阳 极氧化和退火处理得到 Fe 掺杂改性的 TiO₂纳米管阵 列电极和 N 掺杂改性的 TiO₂纳米管阵列电极,分别记 为 Fe-1、Fe-5、Fe-9、N-1、N-5、N-9。

掺杂实验的 Fe、N 元素所使用化学试剂为 FeCl₃·6H₂O 和 CO(NH₂)₂。

用场发射扫描电子显微镜(SEM)观察 TiO₂纳米 管的微观形貌,用 X 射线衍射仪(XRD)对其及晶体 结构进行测试分析,测试条件为:Cu 靶 Kα 辐射,管 电压 40 kV,管电流 40 mA,扫描范围 20°~80°。采用 X 射线光电子能谱(XPS)检测 Fe、N 元素是否成功 掺杂进入了 TiO₂纳米管阵列。

光电化学性能测试在单室的三电极体系中进行, TiO₂纳米管电极为工作电极,辅助电极为铂片,饱和 甘汞电极作为参比电极,0.5 mol/L 的 Na₂SO₄为支持 电解质。采用电化学工作站在室温下测试,外照光源 采用 45 W 的高效节能灯。采用计时电流法(chrono-

表 1 钛基 TiO₂ 纳米管电极材料的制备条件 Table 1 Preparation conditions of titanium-based TiO₂

nanotube electrode materials				
Number	Voltage/ V	Time/ min	Concentration/ mol·L ⁻¹	Annealing temperature/°C
1	10	30	0.3	650
	20	30	0.3	650
	30	30	0.3	650
2	10	10	0.3	650
	10	30	0.3	650
	10	40	0.3	650
	10	60	0.3	650
3	10	30	0.1	650
	10	30	0.3	650
	10	30	0.5	650
	10	30	1.0	650
4	10	30	0.3	550
	10	30	0.3	650
	10	30	0.3	750
	10	30	0.3	850

amperometry) 在 0 V 电压下,连接开路电压,测 250 s 内的电流-时间(*I-t*)曲线,每 50 s 开关一次光源^[5]。 在光照和非光照条件下,测 300 s 内的开路电位-时间 (*U-t*)曲线(open circuit potential)。在 \pm 1 V 间,10 mV/s 的 扫 速 下^[6],用线性伏 安 扫 描 (linear sweep voltammetry)测得 *I-V* 曲线。

2 结果与讨论

2.1 TiO₂纳米管阵列 SEM 形貌表征

图 1a 为未处理钛片的扫描电镜照片,图 1b、1c、 1d 分别为在 10、20、30 V 的恒定电压下,在 0.3 mol/L 的 NH₄F 电解液中,氧化 30 min 后形成的 TiO₂纳米管 阵列的扫描电镜照片。可以看出,在 10 V 恒定电压下 会形成较为规则的 TiO₂纳米管,孔径约为 30 nm。随着 电压的增大,规则的 TiO₂纳米管开始变形,管状结构 逐渐消失。这是因为在 10 V 的制备电压下,纳米管生 长速度与电压对其腐蚀速率达到了动态平衡,形成的纳 米管阵列有序且规则^[7]。电压大于 10 V 时,纳米管生 长速度小于腐蚀速度,其生长被抑制,管状结构被腐蚀。

图 2a、2b、2c、2d 分别为 10 V 恒定电压下,在 不同浓度的 NH₄F 电解液中氧化 30 min 所形成的 TiO₂ 纳米管的扫描电镜照片。可以看出,浓度为 0.1 mol/L 时,表面还有许多没有氧化的 Ti,或者是形成的 TiO₂ 还没有出现规整的纳米管; NH₄F 浓度为 0.3 mol/L 时 形成的 TiO₂纳米管排列规则且管状结构清晰;当 NH₄F 浓度增大到 0.5 mol/L 时,管状阵列结构存在,但开始 变得不规则; NH₄F 浓度为 1.0 mol/L 时, TiO₂纳米管 阵列大部分发生腐蚀溶解,管状阵列结构完全消失, 表面有明显的凸起。

图 3a、3b、3c、3d 分别为钛片在 10 V 恒定电压下, 在 0.3 mol/L 浓度的 NH₄F 电解液中氧化不同时间形成的 TiO₂ 纳米管形貌。可以看出,在氧化 10 min 时,TiO₂ 表层逐渐溶解,表面形成许多孔径约为 10 nm 的小孔; 氧化 30 min 时,随着 TiO₂ 纳米管的生长,表面的多孔 结构发生腐蚀溶解,形成了排列规则的、紧凑的、竖直 生长的 TiO₂ 纳米管阵列,孔径约为 30 nm;氧化至 40 min 时,部分管状结构消失,这是由于 Ti 在被氧化成 TiO₂ 的过程中氧化物也会被腐蚀溶解,导致纳米管结构坍 塌;随着氧化时间的增加,腐蚀作用明显,60 min 时, 不再有明显的管状结构,可以看见有许多明亮的小突 起,被俗称为"纳米草"^[8],降低了纳米管的长度。

综上,TiO₂纳米管阵列最佳制备条件为:10V的 恒定电压,0.3 mol/L的 NH₄F 电解液,阳极氧化 30 min。

2.2 TiO₂纳米管阵列 XRD 表征

图 4a 为不同退火温度下的 TiO₂ 纳米管的 XRD 图





- 图 1 不同电压下制备的二氧化钛纳米管形貌
- Fig.1 SEM morphologies of original titanium sheet (a) and TiO₂ nanotubes prepared at different constant voltages:
 (b) 10 V, (c) 20 V, and (d) 30 V



图 2 不同电解液浓度下制备的二氧化钛纳米管形貌

Fig.2 SEM morphologies of TiO₂ nanotubes prepared with different NH₄F electrolyte concentrations: (a) 0.1 mol/L, (b) 0.3 mol/L, (c) 0.5 mol/L, and (d) 1.0 mol/L



图 3 不同氧化时间下制备的二氧化钛纳米管形貌

Fig.3 SEM morphologies of TiO₂ nanotubes prepared with different oxidation time: (a) 10 min, (b) 30 min, (c) 40 min, and (d) 60 min

谱。Anatase 为锐钛矿晶型、Rutile 为金红石型、Brookite 为板钛矿型。由图可知,锐钛矿出峰位置在 25.463°, 对应(101)晶面^[9],金红石在 27.655°出峰,对应(110) 晶面。空白试样中钛的出峰位置在 38.504°、40.36°、 53.039°、70.846°,说明不存在锐钛矿和金红石晶型。 然而 550 ℃退火处理后的 TiO₂纳米管开始出现锐钛矿 和金红石型的混合晶型,随着温度的升高,金红石晶型 的组成比例在混合晶型中升高,可见,高温使 TiO₂纳 米管晶型发生转变。研究表明,锐钛矿和金红石型的混 合晶型活性较高^[10],可得出 650 ℃为最佳的退火温度。

图 4b 为空白、Fe-1、Fe-5、Fe-9 不同 Fe 浓度掺 杂试样的 XRD 图谱。通过分析可知,未掺杂的 TiO₂ 金红石晶型出峰位置为 27.649°,掺杂后的 Fe-1,出峰 位置在 27.638°, Fe-5 在 27.604°, Fe-9 在 27.573°,可 见随着 Fe 元素掺杂浓度变大,金红石出峰角度有向左 的小幅度偏移,峰高是随着掺杂离子浓度变大而变低。





Fig.4 XRD patterns of TiO₂ nanotubes prepared under different annealing temperatures (a), Fe concentrations (b), and N concentrations (c)

图 4c 为空白、N-1、N-5、N-9 不同 N 浓度掺杂 试样的 XRD 图谱。未掺杂的 TiO₂金红石晶型出峰位 置为 27.649°,掺杂后的 N-1,出峰位置在 27.642°, N-5 在 27.550°, N-9 在 27.540°,可见 N 元素的掺杂 规律与 Fe 相同,金红石出峰角度有向左的小幅度偏 移。但是,随着 N 元素掺杂浓度的升高,峰面积明显 减小,说明 N 掺杂会抑制 TiO₂ 晶粒的生长。

2.3 Fe-1、N-1 掺杂的 TiO₂ 纳米管阵列 XPS 表征

图 5a 是 0.1%掺杂的 Fe-1TiO₂纳米管的 XPS 全谱。 由图 5a 可知,制得的样品中含有 Fe、Ti、O 和 C 元 素,说明 Fe 元素成功掺杂进入样品。图 5b 和 5c 分别 为 Ti 2p 轨道和 Fe 2p 轨道的高分辨 XPS 谱图。图 5b 中结合能为 458.45 和 464.2 eV 处的峰为 TiO₂ 晶格中 Ti⁴⁺的特征峰,分别对应 Ti 2p_{3/2}和 Ti 2p_{1/2}^[10]。图 5c 中位于 710.6 和 723.6 eV 的谱峰分别属于 Fe 2p_{3/2}和 Fe 2p_{1/2},表明 Fe 元素是以 Fe³⁺的形式取代了部分 Ti⁴⁺ 进入了 TiO₂ 晶格中,形成 Ti-O-Fe 网络^[11,12]。TiO₂ 晶 格中掺杂 Fe 元素后,捕获大量电子且出现氧空位,氧 空位的存在缩小了 TiO₂ 的禁带宽度,使得外层单子在 很低的能量激发下就能发生跃迁,拓宽了光响应范围。

图 5d 是 0.1%掺杂的 N-1TiO₂纳米管的 XPS 全谱图。可以看出,制得的样品中含有 N、Ti、O 和 C 元素,说

明N元素成功掺杂进入样品,其中280 eV 左右有 C1s 轨道,可能是有机前驱体残留的C元素^[13]。图5e和5f 分别为Ti2p和N1s轨道的高分辨XPS 谱图。图5e中 结合能为458.55和464.35 eV 处的峰为TiO2晶格中Ti⁴⁺ 的特征峰,分别对应Ti2p_{3/2}和Ti2p_{1/2}。Ti2p_{3/2}的结合 能比标准值(458.8 eV)低0.25 eV,是N掺杂后产生 Ti³⁺(457.40 eV)的原因^[14,15]。图5f为N1s在392到 408 eV 的宽谱,399.6 eV 的位置有1个明显的峰。很多 学者把略低于400 eV 的峰归为N代替TiO2晶格中O形 成的N—Ti—O键^[16,17]。同时,N元素进入分子内部后, 使得原来分子中的空间网状结构出现环状结构,削弱了 TiO2分子间原有的结合力,而化合价态的差异又进一步 影响了光响应范围。由于N³⁻取代O²⁻,过剩的电子在低 能量激发下就可以发生跃迁,拓宽了光响应范围^[18]。

Fe、N 元素进入 TiO₂ 晶体内部的形式不同,形成 的网状结构也不同。但都导致电子跃迁,拓宽了其光 响应范围。

综上,通过 XPS 表征得出: Fe、N 元素均已成功 掺杂到样品中。

2.4 光电化学性能分析

2.4.1 Fe 掺杂 TiO₂纳米管的分析

图 6a 为 Fe-1、Fe-5、Fe-9 的 I-t 曲线, 属于瞬态



图 5 0.1%掺杂的 Fe-1、N-1 二氧化钛纳米管的 XPS 谱图

Fig.5 XPS spectra of Fe-1 (a~c) and N-1 (d~f) TiO₂ nanotubes: (a) XPS full spectrum of Fe-1 nanotubes, (b) Ti 2p orbit high resolution XPS spectrum, and (c) Fe 2p orbit high resolution XPS spectrum; (d) XPS full spectrum of N-1 nanotubes, (e) Ti 2p orbit high resolution XPS spectrum, and (f) N 1s orbit high resolution XPS spectrum



图 6 不同浓度 Fe 掺杂电极的光电化学性能测试图

Fig.6 Photoelectrochemical performance test charts of Fe-doped electrodes with different Fe concentrations: (a) transient photocurrent curves, (b) open-circuit potential-time curves, and (c) linear voltammetry scan curves



图 7 不同浓度 N 掺杂电极的光电化学性能测试图

Fig.7 Photoelectrochemical performance test charts of N-doped electrodes with different N concentrations: (a) transient photocurrent curves, (b) open-circuit potential-time curves, and (c) linear voltammetry scan curves

光电流-时间谱。它是公认的研究半导体电极/溶液界面 光生电荷转移特性的有效表征^[16,17]。可以看出,Fe-1、 Fe-5 在光照和非光照转换时电流均有明显的变化,说明 它们对光有敏感效应,具有良好的光电化学特性。出现 这种现象的主要原因是,光照时,半导体电极中产生的 光生电子和光生空穴迅速分离,扩散至电极/溶液的界 面,并建立双电层,而产生开路电压^[18,19]。但 Fe-9 几 乎没有变化,可见 Fe 元素掺杂过多,会直接降低它的 光电活性。图 6b 为 Fe-1、Fe-5、Fe-9 在光照和非光照 时的 *U-t* 曲线。只有 Fe-1 在光照时比非光照条件下具有 更高的开路电位,达到 0.345 V 左右;而 Fe-5 的光电活 性被抑制,光照时开路电位减小;Fe-9 的变化不明显。 图 6c 是 *I-U* 曲线。发现在相同电压下,Fe-9 具有比 Fe-1、 Fe-5 稍大的电流,可能是由于 Fe-9 自身的电阻较小。

终上所述, Fe-1 具有更好的光电响应, 即 Fe 元素的最佳掺杂量为 0.1%。

2.4.2 N 掺杂 TiO₂纳米管的分析

图 7a 为 N-1、N-5、N-9 的 I-t 曲线。可以看出,

3 种材料均有明显的变化, N-9 变化最大, 具有良好的 光电敏感效应。图 7b 为 N-1、N-5、N-9 的 U-t 曲线, 发现 3 种电极光照时的开路电位均大于非光照时, N-9 的电位差最大, ΔU 为 0.035 V; N-5 在光照时的开路 电位最大,约为 0.317 V; 其次是 N-9,约为 0.3 V。 图 7c 为 I-U 图。发现光电活性最差的 N-1 反而具有更 大的电流,可能是其电阻较小。可见电阻小,光电活 性反而会被限制,此结论与 Fe 掺杂结论相符。

综上, N-9 具有最好的光电活性, 可见, 一定范围内, N 元素掺杂量的增加会促进它的光电性能。

3 结 论

 1) TiO₂ 纳米管阵列最佳的制备条件为: 10 V 的恒 定电压, 0.3 mol/L 的 NH₄F 电解液, 阳极氧化 30 min。
 650 ℃为最佳的退火温度。

2)随着 Fe 元素掺杂浓度变大,金红石出峰角度 有向左的小幅度偏移,峰高随着掺杂离子浓度变大而 变低。Fe 元素掺杂过多,会降低它的光电活性。可见, Fe 元素掺杂浓度的变化对它的光电性能有规律性的 影响。N 元素的掺杂规律与 Fe 相似。但是,随着 N 元素掺杂浓度的升高,峰面积明显减小,说明 N 掺杂 会抑制 TiO₂ 晶粒的生长。

3) TiO₂ 晶格中掺杂 Fe、N 元素后,其网络结构均 发生了变化,且拓宽了它的光响应范围。

4) Fe 元素掺杂中, Fe-1 具有更好的光电响应; N 元素掺杂中, N-9 具有最好的光电活性。Fe-1 和 N-9 的 *I-t* 曲线相比, N-9 具有更好的光电敏感效应; 但是 光照时 Fe-1 的开路电位略高于 N-9。

参考文献 References

- [1] Li He(李 贺), Yao Suwei(姚素薇), Zhang Weiguo(张卫国) et al. Rare Metal Materials and Engineering(稀有金属材料与工程)[J], 2007, 36(10): 1749
- [2] Zhang Yaping(张亚萍), Ding Wenming(丁文明), Zhu Haifeng (朱海丰) et al. Journal of Inorganic Materials(无机材料学 报)[J], 2019, 34(8): 797
- [3] Guo Tao, Wang Changzheng, Xu Ping *et al. Global Challenges* [J], 2019, 3(5): 1 800 084 (1-7)
- [4] Liu Haijin(刘海津), Liu Guoguang(刘国光), Hou Zehua(侯泽 华) et al. Rare Metal Materials and Engineering(稀有金属材 料与工程)[J], 2011, 40(4): 723
- [5] Parnicka P, Mazierski P, Lisowski W et al. Results in Physics[J], 2019, 12: 412
- [6] Wang Xiujuan(王秀娟), Fan Xinmin(樊新民). Chemical Engineering and Equipment(化学工程与装备)[J], 2017(3): 1
- [7] Dong Hao(董 浩), Huang Qiuan(黄秋安), Shi Dawei(石大为) et al. Journal of Hubei University, Natural Science(湖北大学

学报,自然科学版)[J],2018,40(02):119

- [8] Niu Dongmei(牛冬梅). Science & Technology Vision(科技视界)[J], 2018, 36: 116
- [9] Qiu Lanxin(邱澜鑫), Dong Rong(董荣), Cai Fanggong(蔡芳 共) et al. Electronic Components & Materials(电子元件与材 料)[J], 2019(11): 1
- [10] Yan Shuang(颜 双). Dissertation for Master(硕士论文)[D]. Qingdao: Qingdao University of Science and Technology, 2018
- [11] Sun Yajing(孙雅静). Dissertation for Master(硕士论文)[D]. Taiyuan: Taiyuan University of Technology, 2018
- [12] Samadi A, Ahmadi R, Hosseini S M. Organic Electronics[J], 2019, 75: 105 405
- [13] Fang Zhi(房 治), Zhou Qingxiang(周庆祥). Acta Chimica Sinica(化学学报)[J], 2012, 70(17): 1767
- [14] Tan Chao(谭 超), Li Yijiu(李义久), Liao Qiangqiang(廖强强) et al. Rare Metal Materials and Engineering(稀有金属材料 与工程)[J], 2011, 40(3): 551
- [15] Wu Jia(武 佳), Zhu Kai(朱 凯), Xu Hao(徐 浩) et al. Chinese Journal of Catalysis(催化学报)[J], 2019, 40(6): 917
- [16] Purbarani M E, Sari F N I, Ting J M. Surface and Coatings Technology[J], 2019, 378: 125 073
- [17] Li Xiaobing, Zhang Tao, Chen Yubin et al. Chemical Engineering Journal[J], 2020, 382(2): 122 783
- [18] Wu Tong, Chen Changlong, Wei Yuling et al. Dalton Transactions[J], 2019, 48(32): 12 096
- [19] Zhao Bin(赵 斌), Zhang Ruijing(张芮境), Shen Qianqian(申 倩倩) et al. Journal of Materials Engineering(材料工程学 报)[J], 2019, 47(8): 90

Study on Photoelectrochemical Performance of Modified TiO₂ Nanotube Array Electrode

Jin Yuxin¹, Shi Yingzhe¹, Wang Xuan^{1,2}

(1. School of Ecology and Environment, Inner Mongolia University, Hohhot 010021, China)

(2. Key Laboratory of Environmental Pollution Control and Waste Recycling, Inner Mongolia Autonomous Region, Hohhot 010021, China)

Abstract: In recent years, the research of doped modified TiO_2 nanotubes as photocatalytic materials has received widespread attention. In this research, anodic oxidation method was used to prepare regular and ordered TiO_2 nanotubes on the surface of Ti plate, and the chemical reagents containing Fe and N elements were directly added to the electrolyte to modify TiO_2 nanotubes. SEM, X-ray diffractometer and X-ray photoelectron spectroscopy were used to characterize TiO_2 nanotubes, and the optimal preparation conditions of TiO_2 nanotubes were determined. Finally, the transient photocurrent curve, open-circuit potential curve, and linear voltammetric scanning curve were used to compare their photoelectrochemical performance. The results show that 1% Fe element doped material has better photoelectric response, and the open circuit potential can reach 0.345 V under light; 9% N element doped material has the best photoelectric activity, and open circuit potential can reach 0.3 V. **Key words:** anodic oxidation method; TiO_2 nanotubes; modify; photoelectrochemical performance

Corresponding author: Wang Xuan, Ph. D., Key Laboratory of Environmental Pollution Control and Waste Recycling, Inner Mongolia Autonomous Region, Hohhot 010021, P. R. China, E-mail: 506817481@qq.com